



2014年12月19日

各 位

会 社 名 株式会社 東芝
東京都港区芝浦1-1-1
代表者名 代表執行役社長 田中 久雄
(コード番号: 6502 東、名)
問合せ先 広報・IR室長 長谷川 直人
Tel 03-3457-2100

韓国SKハイニックス社との訴訟における和解について

本日、韓国SKハイニックス社との訴訟について和解に合意いたしましたので、お知らせいたします。

なお、詳細については添付の公表文をご参照ください。

1. 事実の概要

当社は、本年3月13日に、SKハイニックス社に対して、NAND型フラッシュメモリの技術に関する機密情報を不正に取得・使用したとして、不正競争防止法に基づき損害賠償等を求める民事訴訟を提起しましたが、本日、同社と和解に合意しました。本合意に基づき、当社はSKハイニックス社から278百万米ドルの和解金の支払いを受けます。

2. 決定の理由

当社は、事業競争力の源泉である技術先進性確保のため、不正競争行為に断固たる対処を進めてきましたが、交渉の結果、今般、SKハイニックス社と和解の合意に達したものです。

3. 今後の見通し

本件に伴う2014年度通期の業績予想変更の要否については現在検討中であり、業績予想の変更を行う場合は速やかに公表いたします。

以 上

韓国 SK ハイニックス社との訴訟における和解とメモリ事業における協業拡大について

当社は、NAND型フラッシュメモリの技術に関する機密情報について、韓国 SK ハイニックス社がこれを不正に取得・使用したとして、不正競争防止法に基づく損害賠償等を求める民事訴訟を本年3月13日に東京地裁に提起しましたが、本日、同社と和解に合意しました。本合意に基づき、当社は SK ハイニックス社から和解金の支払いを受けます。

当社は、今後も事業競争力の源泉である技術の先進性を確保していくため、最善の情報漏洩防止体制の構築を図るとともに、不正競争行為に対しては断固たる措置を講じる方針です。

一方、当社と SK ハイニックス社は、2011年から次世代メモリである MRAM を共同で開発するなど従来から提携・取引関係にあります。この和解を機に、両社は新たな協業関係の構築を目的に、DRAM 供給契約及び、特許クロスライセンス契約期間の延長、次世代露光装置候補の一つであるナノインプリントリソグラフィ技術の共同開発について合意しました。これにより、当社のメモリ事業の更なる強化を図ります。

以 上